

Выпуск 2022 года

Руководство по выбору Innodisk

Флэш-память, DRAM модули , Периферийные модули



innodisk

Представляем Innodisk Group

Innodisk Group - это объединение пяти партнеров, которые стремятся создать исключительные решения промышленного уровня.

Вместе мы привносим разнообразный набор знаний и опыта в передовые AI и IoT решения промышленного уровня. У нас представлены продукты: от накопителей и оперативной памяти до AI платформ, коммуникационных и облачных решений.

Таким образом мы можем предложить передовые решения для систем видеонаблюдения, автомобильной промышленности, умных медицинских устройств, умных фабрик и умных городов. Наши продукты соответствуют самым строгим промышленным стандартам надежности и защиты, обеспечивают непрерывную работу в суровых и сложных условиях эксплуатации.



innodisk

Innodisk

Накопители, оперативная память и карты расширения промышленного уровня в сочетании с ПО решениями для облачных технологий.

Aetina

Высокопроизводительные AI устройства на базе лучших графических процессоров



aetina



antzer

Antzer

Связь и системная интеграция для транспортных приложений - обеспечение непрерывного управления автопарком и сбором данных

Millitronic

Высокоскоростная беспроводная связь с использованием 60 ГГц и WiGig - объединение всех компонентов инфраструктуры IoT



MILLITRONIC
INDUSTRIAL WIRELESS COMMUNICATIONS



sysinno

Sysinno

Контроль чистого и безопасного воздуха в помещении и на открытом воздухе благодаря комплексным и надежным датчикам

Содержание

M.2	6
SSD	7
U.2 SSD	9
SATADOM	9
mSATA	10
CF Card	12
SD/micro SD	13
EDC	15
USB	15
nanoSSD	16
Программное обеспечение	17
Встраиваемые компоненты ..	18
Сервер	19
Расширенный температурный диапазон	19
CANbus	21
LAN.....	23
Для приложений видеонаблюдения	25

Компания Innodisk занимается разработкой, производством и продажей флэш-накопителей и DRAM продуктов для промышленного применения, встраиваемых систем и оборудования корпоративного класса. Наша компания предоставляет высококачественный сервис и надёжные изделия всем клиентам для решения любых задач сбора и хранения данных во встраиваемых системах от аэрокосмической и оборонной промышленности до облачных систем хранения данных. В свою очередь, это поспособствовало началу производства периферийных устройств для встраиваемых систем, чтобы помочь расширить промышленные возможности клиентам.

Основанная в 2005 году и имеющая головной офис в Тайбэе, Тайвань, Innodisk служит клиентам по всему миру с инженерами-экспертами и отделами продаж в Китае, Европе, Японии и США. Обладая богатым опытом и непревзойденными знаниями в промышленности, Innodisk разрабатывает продукты с отличным качеством, замечательной производительностью и высокой надежностью.

Абсолютный сервис

Сервис – это не только то, что мы делаем. Это то, кто мы есть.

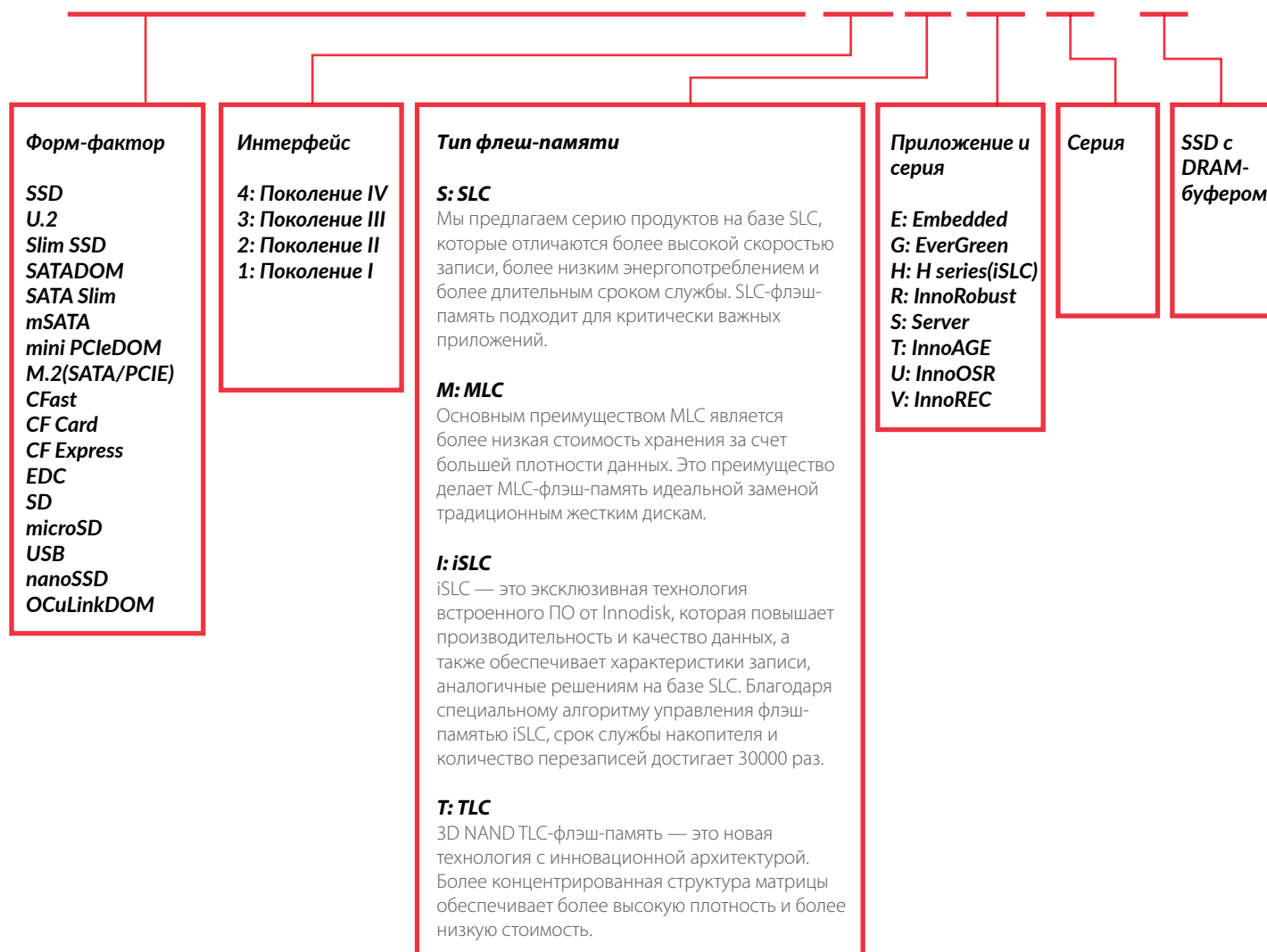
Абсолютный сервис – это наше обещание клиентам.

Обещание предоставить наиболее полный спектр услуг в любой ситуации. Это философия, которой мы придерживаемся во время работы с клиентами и бизнес-партнерами. Это дух дружелюбия и энтузиазма, которым наполнен каждый член команды Innodisk.

Абсолютный сервис – это наша абсолютная приверженность к нашим клиентам.

Наименование твердотельных накопителей

PCIe M.2 2280 3TG6-P



G: EverGreen

Серия EverGreen разработана с DRAM-буфером, который значительно повышает скорость передачи данных на SSD и продлевает срок его службы.

R: InnoRobust

Серия InnoRobust отвечает всем современным требованиям аэрокосмической отрасли. Серия InnoRobust полностью соответствует аэрокосмическим и оборонным стандартам, включая MIL-STD-810G и MIL-I-46058C. Продукты InnoRobust защищены от теплового воздействия, пыли, экстремальных температур, ударов, вибрации и другого влияния окружающей среды. Мы также предоставляем технологии защиты данных для обеспечения безопасности конфиденциальной информации.

E: Embedded

Серия Embedded — лучшее решение для промышленных встраиваемых систем, поскольку они обеспечивают надежность, высокую производительность и длительный срок службы. Мы предлагаем несколько форм-факторов для удовлетворения потребностей клиентов и бизнеса, включая 2,5-дюймовые твердотельные накопители, 1,8-дюймовые твердотельные накопители, SATADOM, mSATA, SATA Slim, SATADOM, iCF & CFast, EDC и SD.

V: InnoREC

Твердотельные накопители InnoREC специально разработаны для приложений видеонаблюдения, усовершенствованные интеллектуальными алгоритмами встроенного ПО, гарантирующими непрерывную и стабильную запись данных.

S: Server

Загрузочные устройства для серверов SATADOM® разработаны для простой интеграции с сервером и обеспечивают высокую надежность работы. Устройства сертифицированы для работы с гипервизорами Windows Server 2016 Hyper V и VMware.

Наша специализация

Innodisk фокусируется на предоставлении надежной флеш-памяти и технологий для ответственных применений. Мы понимаем, насколько важно качество промышленных дисков и DRAM модулей. Именно поэтому вся продукция Innodisk производится на нашем собственном заводе промышленного класса.

Также у нас есть команда ПО разработчиков, которая имеет многолетний опыт в области кастомизации, что позволяет быстро и точно реагировать на запросы клиентов и поставлять высоконадежные индивидуальные решения.



Для промышленных и встраиваемых систем

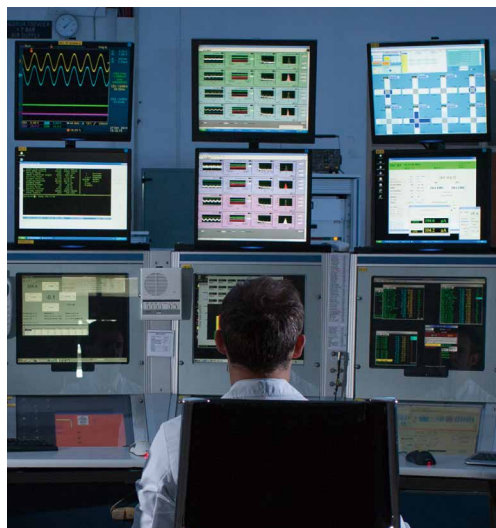
Наши продукты представлены в широком диапазоне промышленных/встраиваемых систем, от автоматизации, телекоммуникаций и транспорта до медицинского оборудования. Мы также предлагаем кастомизацию изделий для различных условий работы и разных температур.

Для промышленных и встраиваемых систем

Сети и телекоммуникации

Сети и телекоммуникации

Innodisk предлагает решения, которые обеспечивают производительность сетевых стандартов нового поколения, таких как 5G и Wi-Fi 6. Благодаря дополнительно усиленной конструкции и уникальным технологиям, обеспечивающим стабильность работы в любой среде, наши продукты идеально подходят для ресурсоемкого периферийного сетевого оборудования, а также для серверных приложений, требующих высочайшей производительности.



Видеонаблюдение

Основная проблема для современных приложений видеонаблюдения — это стабильная запись данных. С нашими комплексными функциями серии InnoREC™ прошивка оптимизирована для обеспечения долговременной и стабильной записи данных, без потери качества. В условиях ограниченного пространства системы и одновременных операций чтения/записи также необходимы высокоскоростные и компактные ОЗУ решения. Наши модули Very Low-Profile (VLP) и Mini DIMM сочетают компактный форм-факторы с высокой производительностью, гарантируя бесперебойную запись данных.

Видеонаблюдение

Технические инновации

Innodisk продолжает поставлять самые инновационные решения для промышленной отрасли, разрабатывая собственные технологии. Вот некоторые из примеров инноваций компании Innodisk.

Pin 7/8 Без кабели



«Pin 7» и «Pin 8» - это запатентованные технологии соединения SATA устройство-хост. Данные технологии устраняют необходимость в кабелях для подачи питания, делая твердотельные накопители (SSD) более ударопрочными и подходящими для экстремальных условий эксплуатации. «Pin 7»/«Pin 8» — это выбор для системных интеграторов, которым требуется гибкость, надежность и максимальное пространство для разработки своих систем. Обе технологии используются в серии Innodisk SATADOM, которая представлена в серверных платах Romley от Intel.

iSMART



iSMART — это мощный и простой в использовании инструмент мониторинга здоровья твердотельного накопителя (SSD) и памяти DRAM. Эта программа позволяет системным интеграторам отслеживать важную информацию о диске, например, температуру, ёмкость диска, неисправные блоки (bad blocks), продолжительность работы диска и программного обеспечения. С iSMART, системные интеграторы смогут лучше понять, как правильно эксплуатировать диск и, когда заменить диск прежде, чем закончится его рабочий ресурс.

iCell



iCell — это умная технология защиты данных, которая встроена в твердотельные накопители (SSD) Innodisk. Технология iCell особенно важна в устройствах для ответственных применений, где работа в экстремальных условиях и без резервного питания является необходимостью. С помощью нашей технологии iCell все данные, временно хранящиеся в энергозависимых DRAM модулях будут мгновенно перенесены на флэш-память, чтобы обеспечить безопасность данных во время сбоев питания.

Температурный датчик



Датчик температуры от Innodisk — это особая технология, встроенная в наши DRAM модули и флэш-память, которая позволяет управлять рабочей нагрузкой в зависимости от температурных изменений. Эта технология подойдёт для промышленных и ответственных применений, где устройства часто работают в режиме перегрузок и при высоких температурах. Температурный датчик Innodisk помогает снизить рабочую температуру, регулируя поведение передачи данных, что предотвращает модули от перегрузок и перегрева и в значительной степени повышает производительность и стабильность системы.

iData Guard



Технология iData Guard является комплексным механизмом защиты данных, который функционирует до и после внезапного отключения питания твердотельного диска (SSD). Детектор низкой мощности подаст сигнал о прекращении записи данных до внезапного отключения питания, а таблица переназначений (table-remapping) удалит поврежденные данные и обеспечит целостность данных после включения питания. iData Guard обеспечивает эффективное управление электропитанием, снижая вероятность потери данных и/или их искажения.

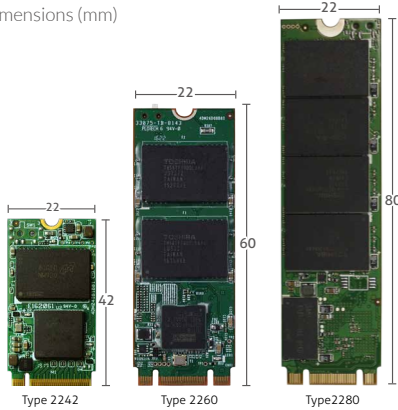
M.2

Innodisk M.2 серия промышленного класса с компактным форм-фактором, обеспечивает высокую производительность. M.2 серия включает интерфейс NVMe и SATA. NVMe разработан специально для флэш-устройств для высокой скорости передачи данных в промышленной отрасли.

Основные характеристики M.2 NVMe

- Промышленный твердотельный накопитель PCIe NVMe
- Доступен широкий диапазон форм-факторов и размеров, включая 2242 и 2280
- Поддержка широкого диапазона рабочих температур от -40 до +85°C.
- Технологии iData Guard, iPower Guard и iCell для защиты и целостности данных при сбоях электропитания.
- Мониторинг состояния диска через утилиту iSMART™
- Сквозная защита пути передачи данных (ETEP)

Dimensions (mm)



Наименование	M.2 (P42) 3TE6	M.2 (P42) 3TE6 В+М ключи	M.2 (P42) 3IE6 В+М ключи	M.2 (P80) 3TE6	M.2 (P80) 3TE6 В+М ключи	M.2 (P80) 3IE6 В+М ключи
Основные характеристики	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Антивибрационная конструкция 4. Режим гибридной записи 5. Поддерживается LDPC ECC 6. iPowerGuard функция защиты данных при сбоях питания	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Антивибрационная конструкция 4. Режим гибридной записи 5. Поддерживается LDPC ECC 6. iPowerGuard функция защиты данных при сбоях питания	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Антивибрационная конструкция 4. Поддерживается LDPC ECC 5. iPowerGuard функция защиты данных при сбоях питания	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Антивибрационная конструкция 4. Режим гибридной записи 5. Поддерживается LDPC ECC 6. iPowerGuard функция защиты данных при сбоях питания	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Антивибрационная конструкция 4. Режим гибридной записи 5. Поддерживается LDPC ECC 6. iPowerGuard функция защиты данных при сбоях питания	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Антивибрационная конструкция 4. Поддерживается LDPC ECC 5. iPowerGuard функция защиты данных при сбоях питания
Коннектор	М ключ	В+М ключи	В+М ключи	М ключ	В+М ключи	В+М ключи
Интерфейс	PCIe Gen3x4	PCIe Gen3x2	PCIe Gen3x2	PCIe Gen3x4	PCIe Gen3x2	PCIe Gen3x2
Тип флеш-памяти	3D TLC	3D TLC	iSLC (3D TLC)	3D TLC	3D TLC	iSLC (3D TLC)
Емкость	64GB~1TB	64GB~1TB	20GB~160GB	64GB~2TB	64GB~2TB	20GB~320GB
Макс. канал	4	4	4	4	4	4
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	2000/1800	1650/1480	1650/1450	2000/1850	1550/1650	1650/1500
Максимальное энергопотребление	3,3 Вт (3,3 В x 1000 мА)	3,5 Вт	3,5 Вт	3,5 Вт (3,3 x 1050 мА)	5,3 Вт	5 Вт
Термо датчик	Да	Да	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
iData Guard	Да	Да	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
TRIM	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ATA Security	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	22,0 x 42,0 x 3,5	22,0 x 42,0 x 3,5	22,0 x 42,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5
Рабочая среда	Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/ Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов					
Стандартная темп. (0+70°C)	DEM24-XXXDD1%С*** DEM24-XXXDD1GС***	DEM24-XXXDD1ECC**	DHM24-XXXDD1ECC**	DEM28-XXXDD1%С****	DEM28-XXXDD1ECC**	DHM28-XXXDD1ECC**
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DEM24-XXXDD1%W***	DEM24-XXXDD1EWC**	DHM24-XXXDD1EWC**	DEM28-XXXDD1%W***	DEM28-XXXDD1EWC**	DHM28-XXXDD1EWC**
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 1 Тб=01Т, 2 Тб=02Т, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G, 160 Гб=A60), ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти					

Наименование	M.2 (P80) 4TE	M.2 (P80) 3TG3-P	M.2 (P80) 3TG6-P	M.2 (P80) 4TG-P	M.2 (P80) 4TG2-P	M.2 (P80) 4TS2-P
Основные характеристики	1. Без DRAM буфера 2. Поддержка NVMe 1.3 3. iData Guard функция защиты данных при сбоях питания 4. Сквозная защита пути передачи данных 5. Технология HMB 6. Шифрование AES 7. Поддержка расширенного темп. диапазона	1. Тип-2280-D2-M ключ 2. Сверхвысокая производительность 3. Поддержка NVMe 1.3 4. iData Guard функция защиты данных при сбоях питания 5. Сквозная защита пути передачи данных	1. DRAM буфер 2. Поддержка NVMe 1.3 3. iData Guard функция защиты данных при сбоях питания 4. Сквозная защита пути передачи данных	1. DRAM буфер 2. Поддержка NVMe 1.3 3. iData Guard функция защиты данных при сбоях питания 4. Сквозная защита пути передачи данных 5. Шифрование AES 6. Поддержка расширенного темп. диапазона	1. DRAM буфер 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Большая емкость 4. Стабильно высокая производительность 5. Технология HMB 6. Шифрование AES	1. DRAM буфер 2. Поддержка NVMe 1.3 3. Большая емкость 4. Долгий срок службы 5. Технология HMB 6. Шифрование AES
Коннектор	M ключ	M ключ	M ключ	M ключ	M ключ	M ключ
Интерфейс	PCIe Gen4x4	PCIe Gen3x4	PCIe Gen3x4	PCIe Gen4x4	PCIe Gen4x4	PCIe Gen4x4
Тип флеш-памяти	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Емкость	128GB~2TB	128GB~2TB	64GB~2TB	128GB~2TB	128GB~4TB	480GB~3.84TB
Макс. канал	4	8	8	4	8	8
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	2800/1800	3400/2800	3400/2700	2800/1800	6500/5300	6500/5300
Максимальное энергопотребление	Подлежит уточнению	6,27 Вт (3,3 x 1900 мА)	5,6 Вт (3,3 В x 1700 мА)	Подлежит уточнению	8,0 Вт	Подлежит уточнению
Термо датчик	Да	Да	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
iData Guard	Да	Да	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Подлежит уточнению	Нет	Нет	Опционально
TRIM	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ATA Security	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5	22,0 x 80,0 x 3,5
Рабочая среда	Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/ Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов					
Стандартная темп. (0+70°C)	DEM28-XXXMB1GC***	DGM28-XXXDA1EC***	DGM28-XXXDC1EC*** DGM28-XXXDC1GC***	DGM28-XXXMA1GC***	DGM28-XXXG21KC***	DSM28-XXXG21KC***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DEM28-XXXMB1GW***	DGM28-XXXDA1HW***H	DGM28-XXXDC1EW***	DGM28-XXXMA1GW***	Подлежит уточнению	Подлежит уточнению
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 1 Тб=01Т, 2 Тб=02Т, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G, 160 Гб=A60), ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти					

SSD

Твердотельные накопители Innodisk обладают очень высокой производительностью. Наш широкий выбор накопителей предназначен для различных приложений, в том числе промышленных/встраиваемых, серверных, для ответственных применений и других полупромышленных приложений, таких как тонкие клиенты (thin clients), POS-терминалы и информационные киоски. Мы предоставляем накопители (SSD) на основе 3D TLC, iSLC, SLC и MLC флэш-памяти, которые поддерживают такие интерфейсы, как PATA/IDE 44 pin, SATA II (3.0 Гбит/с) и SATA III (6.0 Гбит/с).



Наименование	InnoOSR 2,5" SATA SSD 3TO7	InnoAGE 2,5" SATA SSD 3TI7	2,5" SATA SSD 3IE7	2,5" SATA SSD 3TE7
Основные характеристики	1. Резервное копирование и восстановление ОС и данных 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология 4. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 5. Отличная скорость передачи данных	1. Удаленное управление 2. Защита данных 3. Масштабируемость	1. Прошивка промышленного уровня на базе 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология 4. Срок службы в 10 раз дольше, чем у MLC	1. Прошивка промышленного уровня на базе 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология 4. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 5. Отличная скорость передачи данных
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	3D TLC	3D TLC	iSLC (3D TLC)	3D TLC
Емкость	32GB~1TB	64GB-1TB	20GB~320GB	32GB~1TB
Макс. канал	4	4	4	4
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	560/525	560/525	560/525	560/340
Максимальное энергопотребление	3,6 Вт (5 В x 722 мА)	3,6 Вт (5 В x 722 мА)	3,6 Вт (5 В x 722 мА)	3. 6 Вт (5 В x 722 мА)
Термо датчик	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Нет	Нет	Нет
iData Guard	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Нет	Нет
TRIM	Да	Да	Да	Опционально
ATA Security	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	69,8 x 100,1 x 6,9	69,8 x 100,1 x 6,9	69,8 x 100,1 x 6,9	69,8 x 100,1 x 6,9
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартная темп. (0+70°C)	DOS25-XXXDK1EC***	DTS25-XXXDK1EC***	DHS25-XXXDK1%С***	DES25-XXXDK1%С***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DOS25-XXXDK1EW***	DTS25-XXXDK1EW***	DHS25-XXXDK1%W***	DES25-XXXDK1%W***
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 1 Тб=01Т, 2 Тб=02Т, 4 Тб=04Т, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G, 160 Гб=A60, 320 Гб=D2G, 640 Гб=F4G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти			

Наименование	2,5" SATA SSD 3IE6-P	2,5" SATA SSD 3TG6-P	2,5" SATA SSD 3TS6-P
Основные характеристики	1. Сверх производительность при последовательном и случайном чтении и записи на базе 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология обеспечивает дополнительный уровень защиты данных 4. Срок службы в 10 раз дольше, чем у MLC	1. Сверх производительность при последовательном и случайном чтении и записи на базе 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология обеспечивает дополнительный уровень защиты данных	1. Сверх производительность при последовательном и случайном чтении и записи на базе 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология обеспечивает дополнительный уровень защиты данных 4. Сквозная защита пути передачи данных
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	iSLC (3D TLC)	3D TLC	3D TLC
Емкость	80GB~640GB	128GB~4TB	200GB~3.2TB
Макс. канал	4	4	4
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	540 /470	540 /470	540 /470
Максимальное энергопотребление	80 Гб ~ 320 Гб 3,1 Вт (5 В x 620 мА) 640 Гб 6 Вт (5 В x 1200 мА)	128 Гб ~ 1 Тб 3,1 Вт (5 В x 620 мА) 2Тб~4Тб 6 Вт (5 В x 1,2 А)	5,5 Вт
Термо датчик	Да	Да	Да
DRAM буфер	Да	Да	Да
iData Guard	Да	Да	Да
iCell	Опционально	Опционально	Да
TRIM	Да	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	69,8 x 100,1 x 6,9	69,8 x 100,1 x 6,9	69,8 x 100,1 x 6,9
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов		
Стандартная темп. (0+70°C)	DHS25-XXXM71%С***	DGS25-XXXM71%С***(P)	DSS25-XXXM71КС***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DHS25-XXXM71%W***	DGS25-XXXM71%W***(P)	TBD
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 1 Тб=01Т, 2 Тб=02Т, 4 Тб=04Т, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G,160 Гб=A60, 320 Гб=D2G, 640 Гб=F4G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти		

Наименование	2,5" SATA SSD 3ME4	2,5" SATA SSD 3MG2-P	2,5" SATA SSD 3MR2-P
Основные характеристики	1. Эксклюзивная архитектура L3 2. Наличие LDPC ECC 3. Отличная производительность IOPS	1. Архитектура EverGreen L ² 2. Высокая производительность IOPS 3. Поддержка функции DEVSLP 4. Защита данных iData Guard при сбоях питания	1. Соответствует стандарту MIL-STD-810G 2. Аппаратная и программная защита данных (Быстрое стирание/Выведение из строя на аппаратном уровне/ Стирание всех данных/ Защита от несанкционированного изменения данных) 3. Высокая производительность случайной передачи данных 4. Поддержка iCell, 100% защита данных при сбоях питания
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	MLC	MLC	MLC
Емкость	8GB~256GB	8GB~2TB	8GB~2TB
Макс. канал	2	4	4
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	530/210	520/480	520/450
Максимальное энергопотребление	0,8 Вт (5 В x 160 мА)	6 Вт (5 В x 1,2 А)	6 Вт (5 В x 1,2 А)
Термо датчик	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Да	Да
iData Guard	Да	Да	Да
iCell	Нет	Опционально	Да
TRIM	Да	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	69,8 x 100,1 x 6,9	69,8 x 100,1 x 6,9 69,8 x 100,0 x 9,5 (2TB)	69,8 x 99,8 x 9,2
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов		
Стандартная темп. (0+70°C)	DES25-XXXM41%С***	DGS25-XXXD81%С***(P)	DRS25-XXXD82%С***(P)
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DES25-XXXM41%W***	DGS25-XXXD81%W***(P)	DRS25-XXXD82%W***(P)
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 1 Тб=01Т, 2 Тб=02Т, 4 Тб=04Т, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G,160 Гб=A60, 320 Гб=D2G, 640 Гб=F4G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти		

U.2 SSD

U.2 SSD от Innodisk — это NVMe Express SSD-диск, по стандартам PCIe SFF-8639 с PCIe-интерфейсом и на базе 3D TLC NAND-флеш. Поддерживает PCIe Gen III x4, и совместим с NVMe 1.3, обеспечивая отличную функциональность. Благодаря технологиям усовершенствованного обнаружения и коррекции ошибок (ECC), этот модуль обеспечивает полную сквозную защиту пути передачи данных, который защищает данные от хоста до NAND-флеш-памяти.



Наименование	U.2 SSD 3TG6-P				
Основные характеристики	1. PCIe Gen. III x4, NVMe 1.3 2. Отличная скорость передачи данных 3. Наличие теплоотвода 4. Поддерживается технология LDPC ECC. 5. Сквозная защита пути передачи данных 6. Стабильная производительность записи				
Интерфейс	PCIe Gen3x4				
Тип флеш-памяти	3D TLC				
Емкость	128GB~2TB				
Макс. канал	8				
Последовательная скорость Чтения/Записи (МБ/сек, макс.)	3100/2600				
Максимальное энергопотребление	6,78 Вт				
Термо датчик	Да				
DRAM буфер	Да				
iData Guard	Да				
iCell	Нет				
TRIM	Да				
ATA Security	Нет				
S.M.A.R.T.	Да				
Габариты (ШхДхВ/мм)	100,0 x 69,9 x 6,9				
Рабочая среда	Удар: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов				
Стандартная темп. (0+70°C)	DGEU2-XXXDC1%С***				
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DGEU2-XXXDC1%W***				
Примечание	XXX = емкость (128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 1 Тб=01Т, 2 Тб=02Т) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %=Тип флеш-памяти				

SATADOM

SATADOM® – это модуль, устанавливаемый в стандартный разъем SATA на плате. Он является самым маленьким в мире форм-фактором с эксклюзивной технологией Pin 7 и Pin 8 VCC, что упрощает конструкцию материнской платы. Так как данный форм-фактор не нуждается во внешних кабелях, он является более надежным и улучшает работу дисков для промышленного применения, встраиваемых систем и оборудования корпоративного класса. SATADOM® от Innodisk также поддерживает интерфейсы SATA II и SATA III с более высокой скоростью передачи данных и емкостью от 128 Мбайт до 512 Гбайт.



Фактор формы	SATADOM-SV/SH				
Наименование	SATADOM 3IE7	SATADOM 3TE7	SATADOM 3SE4	SATADOM 3IE4	SATADOM 3ME4
Основные характеристики	1. Прошивка промышленного уровня, 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология 4. Срок службы в 10 раз дольше, чем у MLC	1. Прошивка промышленного уровня, 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология 4. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 5. Отличная скорость передачи данных	1. Высококачественное решение на базе SLC 2. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 3. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD 4. Отличная скорость передачи данных	1. Бюджетное промышленное решение на базе iSLC 2. Эксклюзивная архитектура L3 3. Усовершенствованная технология LDPC ECC 4. Контакт 8/Контакт 7	1. Вертикальный или низкопрофильный горизонтальный тип 2. Эксклюзивная архитектура L3 3. Усовершенствованная технология LDPC ECC 4. Высокие характеристики IOPS 5. Контакт 8/Контакт 7
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	iSLC (3D TLC)	3D TLC	SLC	iSLC (MLC)	MLC
Емкость	20GB~80GB	32GB~256GB	8 Гб~32 Гб	8GB~64GB	8GB~128GB
Макс. канал	2	2	2	2	2
Последовательная скорость Чтения/Записи (МБ/сек, макс.)	550/485	510/300	520/260	530/350	530/120
Максимальное энергопотребление	1,3 Вт (5 В x 260 мА)	1,55 Вт (5 В x 309 мА)	1,58 Вт (5 В x 315 мА)	0,95 Вт (5 В x 189 мА)	1,27 Вт (5 В x 254 мА)
Термо датчик	Да	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
iData Guard	Да	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
TRIM	Да	Да	Да	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	SV: 40,4 x 21,03 x 10,4 SH: 32,7 x 18 x 14,15	SV: 40,4 x 21,03 x 10,4 SH: 32,7 x 18 x 14,15	SV: 40,4 x 21,03 x 10,4 SH: 32,7 x 18 x 14,15	SV: 40,4 x 21,03 x 10,4	SV: 40,4 x 21,03 x 10,4 SH: 32,7 x 18 x 15,15
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц Ударостойкость: 1500G@0,5 мс Темп. в состоянии покоя: -40+85°C MTBF: >3 миллиона часов				
Стандартная темп. (0+70°C)	SV:DHSSV-XXXDK1EC*** SH:DESSH-XXXDK1EC***	SV:DESSV-XXXDK1EC*** SH:DESSH-XXXDK1EC***	SV:DESSV-XXXM41SC*** SH:DESSH-XXXM41SC***	SV:DHSSV-XXXM41BC***	SV:DESSV-XXXM41BC*** SH:DESSH-XXXM41BC***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	SV:DHSSV-XXXDK1EW*** SH:DESSH-XXXDK1EW***	SV:DESSV-XXXDK1EW*** SH:DESSH-XXXDK1EW***	SV:DESSV-XXXM41SW*** SH:DESSH-XXXM41SW***	SV:DHSSV-XXXM41BW***	SV:DESSV-XXXM41BW*** SH:DESSH-XXXM41BW***
Примечание	xxx = емкость (08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) #= электропитание (A= контакт 8 + кабель внешнего питания / B= контакт 7+ контакт 8)				

Фактор формы	SATADOM-ML/MH				
Наименование	SATADOM 3SE4	SATADOM 3IE4	SATADOM 3ME4	SATADOM 3TG6-P	SATADOM 3MG2-P
Основные характеристики	1. Высококачественное решение на базе SLC 2. Без DRAM, высокий уровень целостности данных 3. Технология LDPC обеспечивает надежность SSD 4. Отличная скорость передачи данных	1. Поддержка аппаратной защиты от несанкционированного изменения данных 2. Бюджетное промышленное решение на базе iSLC 3. Эксклюзивная архитектура L3 4. Усовершенствованная технология LDPC ECC 5. Высокие характеристики IOPS 6. Контакт 8/Контакт 7	1. Поддержка аппаратной защиты от несанкционированного изменения данных 2. Эксклюзивная архитектура L3 3. Усовершенствованная технология LDPC ECC 4. Высокие характеристики IOPS 5. Контакт 8/Контакт 7	1. Ультра производительность при последовательном и случайном чтении и записи на базе 3D NAND 2. Усовершенствованная технология LDPC ECC 3. RAID технология обеспечивает дополнительный уровень защиты данных 4. Сквозная защита пути передачи данных AES 256-key	1. Поддержка аппаратной защиты от несанкционированного изменения данных 2. Высокие характеристики IOPS 3. Высокая производительность
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	SLC	iSLC (MLC)	MLC	3D TLC	MLC
Емкость	8GB~64GB	16GB~128GB	32GB~256GB	128GB~256GB	32GB-256GB
Макс. канал	2	2	2	4	4
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	520/360	530/360	530/210	560/290	560/180
Максимальное энергопотребление	1,58 Вт (5 В x 315 мА)	0,815 Вт (5 В x 163 мА)	0,815 Вт (5 В x 163 мА)	2,14 Вт (5 В x 428 мА)	2,68 Вт (5 В x 535 мА)
Термо датчик	Да	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Нет	Нет	Да	Да
iData Guard	Да	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
TRIM	Да	Да	Да	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	ML: 36,7 x 31,2 x 10,7	ML: 31,2 x 36,7 x 10,7 MH: 23,5 x 33,6 x 14,8	ML: 31,2 x 36,7 x 10,7 MH: 23,5 x 33,6 x 14,8	ML: 37,17 x 31,5 x 12,6	ML: 37,17 x 31,5 x 12,6
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц Ударостойкость: 1500G@0,5 мс Темп. в состоянии покоя: -40+85°C MTBF: >3 миллиона часов				
Стандартная темп. (0+70°C)	ML: DESML-XXXM41SC*** MH: DESMH-XXXM41SC***	ML: DHSML-XXXM41BC*** MH: DHSMH-XXXM41BC***	ML: DESML-XXXM41BC*** MH: DESMH-XXXM41BC***	ML: DGSML-XXXM71EC***	ML: DGSML-XXXD81BC***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	ML: DESML-XXXM41SW*** MH: DESMH-XXXM41SW***	ML: DHSML-XXXM41BW*** MH: DHSMH-XXXM41BW***	ML: DESML-XXXM41BW*** MH: DESMH-XXXM41BW***	ML: DGSML-XXXM71EW***	ML: DGSML-XXXD81BW***
Примечание	xxx = емкость (08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) #= электропитание (A= контакт 8 + кабель внешнего питания / B= контакт 7+ контакт 8)				

mSATA

mSATA, который соответствует стандарту JEDEC MO300 / MO300B, был объявлен Международной Организацией Serial ATA (Serial ATA International Organization) 21 сентября 2009 года. Данный твердотельный накопитель подходит для ноутбуков, портативных устройств и других устройств, которым требуется накопитель размера. Разъем mSATA похож на интерфейс PCI Express Mini Card и электрически совместим; однако, сигналам данных необходимо подключение к хост- контроллеру SATA вместо PCI-express хост-контроллера. mSATA от Innodisk поддерживает высокую скорость передачи данных 1.5 Гбит/с, 3.0 Гбит/с и 6.0 Гбит/с.



Наименование	InnoAGE mSATA 3TI7	mSATA 3IE7	mSATA 3TE7	mSATA 3TG6-P
Основные характеристики	1. Дистанционное управление 2. Защищенность данных 3. Масштабируемость	1. Прошивка промышленного уровня, 3D NAND 2. Усовершенствованная функция LDPC ECC 3. RAID технология 4. Срок службы в 10 раз дольше, чем у MLC	1. Прошивка промышленного уровня, 3D NAND 2. Поддержка LDPC ECC 3. RAID технология 4. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 5. Отличная скорость передачи данных	1. Высокая производительность при последовательном и случайном чтении/записи на базе 3D NAND 2. Поддержка LDPC ECC 3. RAID технология обеспечивает дополнительный уровень защиты данных
Интерфейс	SATA III 6.0Гб/с	SATA III 6.0Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	3D TLC	iSLC (3D TLC)	3D TLC	3D TLC
Емкость	64GB-256GB	20GB~640GB	32GB~1TB	128GB~1TB
Макс. канал	4	4	4	4
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	535/260	550 / 490	560/330	560/510
Максимальное энергопотребление	2,2 Вт (3,3 В x 674 мА)	2,7 Вт	2,2 Вт (3,3 В x 674 мА)	2,8 Вт (3,3 В x 850 мА)
Термо датчик	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Нет	Нет	Да
iData Guard	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Опционально (64GB-512GB)	Нет
TRIM	Да	Да	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	29,8 x 50,8 x 3,7	29,8 x 50,8 x 3,7	29,8 x 50,8 x 3,7	29,8 x 50,8 x 3,7
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартная темп. (0+70°C)	DTMSR-XXXDK1EC***	DHMSR-XXXDK1%С***	DEMSR-XXXDK1%С***(P)	DGMSR-XXXM71%С***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	NA	DHMSR-XXXDK1%W***	DEMSR-XXXDK1%W***(P)	DGMSR-XXXM71%W***
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G,160 Гб=A60, 320 Гб=D2G, 640 Гб=F4G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти			

Наименование	mSATA 3SE4	mSATA 3IE4	mSATA 3MG2-P	mSATA 3ME4
Основные характеристики	1. Высококачественное решение на базе SLC 2. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 3. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD 4. Отличная скорость передачи данных	1. Бюджетное промышленное решение на базе iSLC 2. Срок службы в 7 раз дольше, чем у MLC 3. Производительность и качество данных соответствующие типу памяти SLC 4. Отличная скорость передачи данных 5. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD	1. Высокая скорость операций ввода-вывода (IOPS) благодаря DRAM буферу 2. Архитектура L ² , позволяющая увеличить срок эксплуатации 3. Поддержка DEVSLP	1. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD 2. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	SLC	iSLC (MLC)	MLC	MLC
Емкость	8GB~64GB	8GB~128GB	8GB~512GB	8GB~256GB
Макс. канал	2	2	4	2
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	525/350	530/365	520/450	535/210
Максимальное энергопотребление	1,32 Вт (3,3 В x 400 мА)	0,6 Вт (3,3 В x 200 мА)	2,2 Вт (3,3 В x 660 мА)	0,6 Вт (3,3 В x 205 мА)
Термо датчик	Да	Да	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Нет	Да	Нет
iData Guard	Да	Да	Да	Да
iCell	Нет	Нет	Нет	Нет
TRIM	Да	Да	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	29,8 x 50,8 x 3,7	29,8 x 50,8 x 3,7	29,8 x 50,8 x 3,7	29,8 x 50,8 x 3,7
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартная темп. (0+70°C)	DEMSR-XXXM41SC***	DHMSR-XXXM41BC***	DGMSR-XXXD81SC***	DEMSR-XXXM41BC***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DEMSR-XXXM41SW***	DHMSR-XXXM41BW***	DGMSR-XXXD81SW***	DEMSR-XXXM41BW***
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G, 160 Гб=A60, 320 Гб=D2G, 640 Гб=F4G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти			

Наименование	mSATA mini 3TE7	mSATA mini 3SE4	mSATA mini 3IE4	mSATA mini 3ME4
Основные характеристики	1. Прошивка промышленного уровня, 3D NAND 2. Поддержка LDPC ECC 3. RAID технология 4. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 5. Отличная скорость передачи данных	1. Высококачественное решение на базе SLC 2. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных 3. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD 4. Отличная скорость передачи данных	1. Бюджетная промышленная флеш-память на базе iSLC 2. Срок службы в 7 раз дольше, чем у MLC 3. Производительность и качество данных соответствующие типу SLC 4. Отличная скорость передачи данных 5. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD	1. Технология LDPC обеспечивает надежность работы SSD 2. Без DRAM буфера, высокий уровень целостности данных
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с	SATA III 6.0 Гб/с
Тип флеш-памяти	3D TLC	SLC	iSLC (MLC)	MLC
Емкость	32GB~512GB	8GB~64GB	8 Гб~64 Гб	8GB~128GB
Макс. канал	4	*Для 4GB, см. mSATA mini 3SE3	2	2
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	560/330	2	530/340	430/125
Максимальное энергопотребление	0,6 Вт (3,3 В x 190 мА)	525/360	0,6 Вт (3,3 В x 200 мА)	0,6 Вт (3,3 В x 190 мА)
Термо датчик	Да	1,3 Вт (3,3 В x 400 мА)	Да	Да
DRAM буфер	Нет	Да	Нет	Нет
iData Guard	Да	Нет	Да	Да
iCell	Нет	Да	Нет	Нет
TRIM	Да	Нет	Да	Да
ATA Security	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	30 x 26,8 x 3,6	30 x 26,8 x 3,4	30 x 26,8 x 3,4	30 x 26,8 x 3,4
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартная темп. (0+70°C)	DEMSM-XXXDK1EC***	DEMSM-XXXM41SC***	DHMSM-XXXM41BC***	DEMSM-XXXM41BC***
Широкий темп. диапазон: (-40+85°C)	DEMSM-XXXDK1EW***	DEMSM-XXXM41SW***	DHMSM-XXXM41BW**	DEMSM-XXXM41BW***
Примечание	XXX = емкость (02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 20 Гб=20G, 40 Гб=40G, 80 Гб=80G, 160 Гб=A60, 320 Гб=D2G, 640 Гб=F4G) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти			

CF Card

Промышленные карты памяти CompactFlash от Innodisk (iCF) соответствуют стандарту PCMCIA*ATA и предназначены для замены традиционных жестких дисков. iCF от Innodisk – это встраиваемые твердотельные накопители для мобильных компьютеров и приложений в сфере промышленности.



Наименование	iCF 9000	iCF 1SE
Основные характеристики	1. Высокая стабильная скорость передачи данных 2. Усовершенствованное управление циклами питания	Высококачественное решение на базе SLC
Интерфейс	PATA	PATA
Коннектор	50-контактный CF-разъем	50-контактный CF-разъем
Тип флеш-памяти	SLC	SLC
Емкость	1 Гб~64 Гб	512 Мб~8 Гб
Макс. канал	4	2
Последовательная скорость записи/чтения (МБ/сек, макс.)	110/100	40/30
Максимальное энергопотребление	0,95 Вт (5 В x 190 мА) 0,63 Вт (3,3 В x 190 мА)	0,75 Вт (5 В x 150 мА) 0,5 Вт (3,3 В x 150 мА)
Тепловой датчик	Нет	Нет
ATA Security	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	42,8 x 36,4 x 3,3	42,8 x 36,4 x 3,3
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллионов часов	
Стандартный темп. диапазон (0~70°C)	DC1M-XXXD71AC***	DC1M-XXXD41AC***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DC1M-XXXD71AW***	DC1M-XXXD41AW***
Примечание	Режим PIO 0-6 Режим UDMA 0-7	Режим PIO 0-6 Режим UDMA 0-4
	XXX = емкость (512 Мб=512, 01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56), *** = конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти	

Наименование	iCF 1ME	iCF 1ME2	iCF 1SE2	iCF 1SE3
Основные характеристики	1. Бюджетное решение на базе MLC 2. Усовершенствованное управление циклами питания	1. Бюджетное решение на базе MLC 2. Поддержка iPowerGuard 3. Поддержка iDataGuard	1. Высококачественное решение на базе SLC 2. Усовершенствованное управление циклами питания	1. Функция защиты от несанкционированного изменения данных 2. Устранение нарушений чтения диска 3. Поддержка функции полного стирания данных 4. Поддержка iPowerGuard&iDataGuard для защиты данных при скачках питания
Интерфейс	PATA	PATA	PATA	PATA
Коннектор	50-контактный CF-разъем	50-контактный разъем CF	50-контактный разъем CF	50-контактный разъем CF
Тип флеш-памяти	MLC	MLC	SLC	SLC
Емкость	8 Гб~256 Гб	8 Гб~256 Гб	1 Гб~64 Гб	128 Мб~64 Гб
Макс. канал	2	2	2	2
Последовательная скорость записи/чтения (МБ/сек, макс.)	110/110	85/55	75/65	63/55
Максимальное энергопотребление	0,76 Вт (5 В x 155 мА) 0,52 Вт (3,3 В x 155 мА)	0,85 Вт (5 В x 170 мА)	1,4 Вт (5 В x 280 мА)	0,7 Вт (5 В x 140 мА)
Тепловой датчик	Нет	Нет	Нет	Нет
ATA Security	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	42,8 x 36,4 x 3,3	42,8 x 36,4 x 3,3	42,8 x 36,4 x 3,3	42,8 x 36,4 x 3,3
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллионов часов			
Стандартный темп. диапазон (0~70°C)	DECFC-XXXD53BC***	DECFC-XXXA2BC***	DECFC-XXXD53AC***	DECFC-XXXA2AC***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DECFC-XXXD53BW***	DECFC-XXXA2BW***	DECFC-XXXD53AW***	DECFC-XXXA2AW***
Примечание	Режим PIO 0-6 Режим UDMA 0-7	Режим PIO 0-6 Режим UDMA 0-7	Режим PIO 0-6 Режим UDMA 0-7	Режим PIO 0-6 Режим UDMA 0-7
	XXX = емкость (512 Мб=512, 01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56), *** = конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти			

SD/micro SD

SD и microSD карты от Innodisk - это одноуровневые флэш-устройства, созданные для жестких условий эксплуатации в сфере встраиваемых систем. Данные карты промышленного класса - SD и microSD -обеспечивают высокую скорость до 54 Мбайт в секунду, а также продолжительный срок службы и высокую надежность, особенно по сравнению с другими картами, используемыми на рынке мобильной связи. SD и microSD карты от Innodisk совместимы со стандартами SD 2.0 / SD 3.0 и поддерживают SDHC Class 10 (UHS-I). Они также оснащены SMART технологией, для отслеживания работы этих SD карт.



Наименование	Micro SD 31E4	Micro SD 3TE4	Micro SD 3ME3
Основные характеристики	1. Высокая производительность 2. Долгий срок службы 3. LDPC технология	1. Высокая производительность 2. LDPC технология	1. Class 10 UHS-I 2. Высокая производительность
Интерфейс	SD 3.0	SD 3.0	SD 3.0
Тип флеш-памяти	iSLC (3D TLC)	3D TLC	MLC
Емкость	8GB~128GB	32GB~512GB	8GB~64GB
Макс. канал	1	1	1
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	95/85	95/85	76/52
Максимальное энергопотребление	0,41 Вт (3,3 В x 124 мА)	0,53 Вт (3,3 В x 161 мА)	0,49 Вт (3,3 В x 149 мА)
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	11,0 x 15,0 x 1,0	11,0 x 15,0 x 1,0	11,0 x 15,0 x 1,0
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов		
Стандартный темп. диапазон (-25+85°C)	DHSDM-XXXS06%E**L	DESDM-XXXS06%E**L	DESDM-XXXS02SE***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DHSDM-XXXS06%W**L	DESDM-XXXS06%W**L	DESDM-XXXS02SW***
Примечание	XXX = емкость (01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12) *** = конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти		



Наименование	microSD 3SE3	Карта microSD промышленного класса	microSD 3ME2	microSD 31E2
Основные характеристики	Усовершенствованное управление циклом электропитания	Усовершенствованное управление циклом электропитания	1. Class 10 UHS-I 2. Высокая производительность 3. Поддержка SPI	1. Class 10 UHS-I 2. Высокая производительность 3. Поддержка SPI
Интерфейс	SD 3.0	SD 2.0	SD 3.0	SD 3.0
Тип флеш-памяти	SLC	SLC	MLC	iSLC (MLC)
Емкость	4GB~8GB	1GB~4GB	8GB~64GB	4GB~32GB
Макс. канал	1	1	1	1
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	30/23	20/16	75/31	79/45
Максимальное энергопотребление	01,2 Вт (3,3 В x 387 мА)	0,17 Вт (3,3 В x 50 мА)	0,17 Вт (3,3 В x 219 мА)	0,7 Вт (3,3 В x 219 мА)
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	11,0 x 15,0 x 1,0	11,0 x 15,0 x 1,0	11,0 x 15,0 x 1,0	11,0 x 15,0 x 1,0
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартный темп. диапазон (-25+85°C)	DESDM-XXXS02AE***	DS2M-XXXI81AC***	DESDM-XXXE21SEASK	DHSDM-XXXE21SEASK
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DESDM-XXXS02AW***	DS2M-XXXI81AW***	DESDM-XXXE21SWASK	NA
Примечание	XXX = емкость (01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12) *** = конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти			



Наименование	SD Card 3ME3	SD Card 3IE3	SD Card 3IE4
Основные характеристики	1. Высокая производительность 2. Контроль за сбоями питания 3. Наличие функции BCH ECC	1. Class 10 UHS-I 2. Высокая производительность 3. Долгий срок службы	1. Высокая производительность 2. Долгий срок службы 3. LDPC технология
Интерфейс	SD 3.0	SD 3.0	SD 3.0
Тип флеш-памяти	MLC	iSLC (MLC)	iSLC (3D TLC)
Емкость	8GB~128GB	4GB~64GB	8GB~64GB
Макс. канал	1	1	1
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	80/46	79/70	95/85
Максимальное энергопотребление	0,52 Вт (3,3 В x 158 мА)	0,47 Вт (3,3 В x 143 мА)	0,41 Вт (3,3 В x 124 мА)
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	24,0 x 32,0 x 2,1	24,0 x 32,0 x 2,1	24,0 x 32,0 x 2,1
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов		
Стандартный темп. диапазон (-25+85°C)	DESDC-XXXS02BC***	DHSDC-XXXS02BE***	DHSDC-XXXS06%E**L
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DESDC-XXXS02BW***	DHSDC-XXXS02BW***	DHSDC-XXXS06%W**L
Примечание	XXX = емкость (01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12) *** = конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти		



Наименование	SD Card 3TE4	SD Card 3SE3
Основные характеристики	1. Высокая производительность 2. LDPC технология	Усовершенствование цикла электропитания
Интерфейс	SD 3.0	SD 3.0
Тип флеш-памяти	3D TLC	SLC
Емкость	32GB~256GB	4GB~32GB
Макс. канал	1	1
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	95/85	37/31
Максимальное энергопотребление	0,47 Вт (3,3 В x 144 мА)	0,41 Вт (3,3 В x 123 мА)
S.M.A.R.T.	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	24,0 x 32,0 x 2,1	24,0 x 32,0 x 2,1
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов	
Стандартный темп. диапазон (-25+85°C)	DESDC-XXXS06%E**L	DESDC-XXXS02AE***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DESDC-XXXS06%W**L	DESDC-XXXS02AW***
Примечание	XXX = емкость (01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12) *** = конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля) %= Тип флеш-памяти	

EDC

Embedded Disk Card (EDC) от Innodisk соответствует стандартам PCMCIA * ATA и подходит для всех платформ с разъемом IDE. EDC от Innodisk производятся емкостью от 512 Мбайт до 256 Гбайт и доступны в исполнениях 40-pin и 44-pin.



Наименование	EDC 1SE вертикального типа	EDC 1SE горизонтального типа	EDC 1ME вертикального типа	EDC 1ME горизонтального типа
Основные характеристики	1. Защита от пыли 2. Высококачественное решение на базе SLC	1. Высококачественное решение на базе SLC 2. Наличие крепежного отверстия	1. Бюджетное решение на базе MLC 2. Высокопроизводительное решение PATA	1. Экономичное решение на базе MLC 2. Высокопроизводительное решение PATA
Коннектор	40/44 контактов	40/44 контактов	44-контактный	44-контактный
Интерфейс	PATA	PATA	PATA	PATA
Тип флеш-памяти	SLC	SLC	MLC	MLC
Емкость	512MB~4GB	512MB~8GB	8GB~128GB	8GB~256GB
Макс. канал	2	2	2	2
Последовательная скорость Записи/Чтения (Мб/сек, макс.)	40/28	40/28	110/75	110/75
Максимальное энергопотребление	0,75 Вт (5 В x 150 мА) 0,5 Вт (3,3 В x 150 мА)	0,75 Вт (5 В x 150 мА) 0,5 Вт (3,3 В x 150 мА)	1,05 Вт (5 В x 150 мА) 0,69 Вт (3,3 В x 150 мА)	1,05 Вт (5 В x 150 мА) 0,69 Вт (3,3 В x 150 мА)
Температурный датчик	Нет	Нет	Нет	Нет
DRAM буфер	Нет	Нет	Нет	Нет
ATA Security	Да	Да	Да	Да
S.M.A.R.T.	Да	Да	Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	40 контактов: 60,2 x 27,3 x 6,4 44 контакта: 50,3 x 27,3 x 5,8	40 контактов (A,B тип): 55 x 32,4 x 12,9 40 контактов (C,D тип): 55 x 32,4 x 14,6 40 контактов (E,F тип): 55 x 32,4 x 18,3 44 контакта (A,B тип): 48 x 32,6 x 6,7 44 контакта (C,D тип): 48 x 32,6 x 12,8 44 контакта (E,F тип): 48 x 32,6 x 12,9	50,3 x 27,3 x 7,5	A,B тип: 48 x 32,6 x 7,3
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Удар: 1500G@0,5 мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартный темп. диапазон (0~70°C)	40PIN DE0H-XXXXD41AC*** 44PIN DE4H-XXXXD41AC***	40PIN DE0P%-XXXD41AC*** 44PIN DE4P%-XXXD41AC***	DEE4H-XXXD53BC***	DEE4%-XXXD53BC***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	40PIN DE0H-XXXXD41AW*** 44PIN DE4H-XXXXD41AW***	40PIN DE0P%-XXXD41AW*** 44PIN DE4P%-XXXD41AW***	DEE4H-XXXD53BW***	DEE4%-XXXD53BW***
Примечание	xxx = емкость (512 Мб=512, 01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A2, 256 Гб=B56) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля), %= горизонтальный тип (A,B,C,D,E,F)			

USB

USB серия промышленного класса удобного компактного форм-фактора создана с использованием SLC NAND флэш-памяти. Данная серия отличается большой емкостью хранения данных, обеспечивая при этом более быструю передачу данных. Она также соответствует интерфейсу USB 3.0 и совместима с USB 1.1.



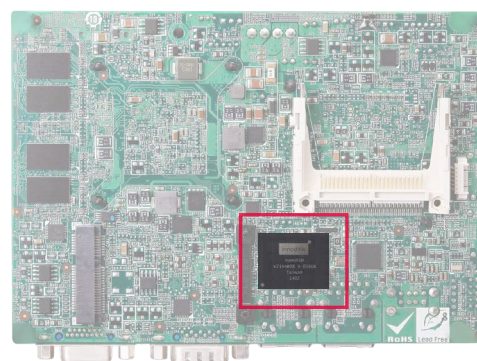
Наименование	USB 2SE2	USB 2ME2	USB 3SE	USB 3ME
Основные характеристики	1. Корпус с защитой от электростатических разрядов 2. Позолоченные контакты с 30μ нанесением для высоконадежной передачи данных		1. Корпус с защитой от электростатических разрядов 2. Позолоченные контакты с 30μ нанесением для высоконадежной передачи данных	
Интерфейс	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0	
Коннектор	Тип A	Тип A	Тип A	
Тип флеш-памяти	SLC	MLC	SLC	MLC
Вместимость	512MB~16GB	8GB~64GB	4GB~32GB	8GB~64GB
Макс. канал	1	1	1	1
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	30/30	40/30	100/85	100/50
Максимальное энергопотребление	0,73 Вт (5 Вx146) (прим.)	0,94 Вт (5 Вx188) (прим.)	0,7 Вт (5 В x 140 мА)	
Габариты (ШxДxВ/мм)	16,60 x 61,45 x 7,60	16,60 x 61,45 x 7,6	16,6 x 48,6 x 7,6	
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс / Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартный темп. диапазон (0+70°C)	DEUA1-XXXDQ1AC1SB	DEUA1-XXXDQ1BC1SC	DEUA1-XXXI61SC***	DEUA1-XXXI61BC***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DEUA1-XXXDQ1AW1SB	DEUA1-XXXDQ1BW1SC	DEUA1-XXXI61SW***	DEUA1-XXXI61BW***
Примечание	XXX = емкость (512 Мб=512, 01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля)			



Наименование	USB EDC вертикального типа 3SE	USB EDC вертикального типа 3ME	USB EDC вертикального типа 3ME	USB EDC горизонтальный тип 2ME2	USB EDC горизонтальный тип 2ME3
Основные характеристики	1. Высокая производительность, интерфейс USB 3.0 2. Низкое энергопотребление 3. Поддерживается технология Wear-leveling для сглаживания изнашиваемости ячеек флеш-памяти		1. Имеется крепежное отверстие 2. 2,0/2,54 мм типы конектора		
Интерфейс	USB 3.0		USB 2.0		
Коннектор	Стандартный, 20-контактный, 2,00 мм		Стандартный 9-контактный 2,54 мм Низкопрофильный 9-контактный 2,00 мм		
Тип флеш-памяти	SLC	MLC	SLC	MLC	MLC
Вместимость	4GB~32GB	8GB~64GB	512MB~32GB	4GB~64GB	512MB~32GB
Макс. канал	1	1	1	1	1
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	110/85	100/50	30/30	25/15 (прим.)	25/15 (прим.)
Максимальное энергопотребление	0,79 Вт (5 В x 158 мА)		0,46 Вт (5 В x 91)	0,85 Вт (5 В x 170 мА) (прим.)	
Габариты (ШxДxВ/мм)	24,0 x 22,0 x 5,0		26,6 x 36,9 x 6,75 мм (2,00 мм тип конектора) 26,6 x 36,9 x 9,85 мм (2,54 мм тип конектора)		
Рабочая среда	Вибрация: 20G@7~2000 Гц/Ударостойкость: 1500G@0,5 мс / Темп. в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов				
Стандартный темп. диапазон (0+70°C)	DEUV1-XXXI61SC***	DEUV1-XXXI61BC***	DEUH%-XXXDQ1AC1SB	DEUH%-XXXDQ1BC1SC	DEUH%-XXXI61BC1SC
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DEUV1-XXXI61SW***	DEUV1-XXXI61BW***	DEUH%-XXXDQ1AW1SB	DEUH%-XXXDQ1BW1SC	DEUH%-XXXI61BW1SC
Примечание	XXX = емкость (512 Мб=512, 01 Гб=01G, 02 Гб=02G, 04 Гб=04G, 08 Гб=08G, 16 Гб=16G, 32 Гб=32G, 64 Гб=64G, 128 Гб=A28, 256 Гб=B56, 512 Гб=C12) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля)				

nanoSSD

nanoSSD от Innodisk является миниатюрным интегрированным твердотельным накопителем с интерфейсом SATA. Накопители nanoSSD сочетают в себе контроллер (ID106/ID108), NAND флэш-память стандарта JEDEC MO-276 (SATA μSSD) и компоненты подсистемы питания, которые размещены в корпусе BGA. Всё это позволило существенно уменьшить габариты накопителей. Несмотря на такие малые размеры, nanoSSD поддерживает интерфейс SATA III 6.0 Гбит/с и обладает высокой скоростью передачи данных, наряду с низким энергопотреблением. Это идеальное решение для любого вида портативных устройств.



Наименование	nanoSSD 3IE3	nanoSSD 3ME3	nanoSSD SATA 3TE7	nanoSSD PCIe 3TE7
Основные характеристики	1. BGA тип при котором контроллер и флеш-память размещаются на одном чипе 2. Отличная совместимость благодаря интерфейсу SATA III 3. Совместимо с JEDEC MO-276 SPEC		1. Высокоинтегрированный SSD IC-типа с SiP. 2. Поддержка работы в широком температурном диапазоне, оригинальная микросхема 3. Сквозная защита пути передачи данных 4. Отличная защита от ударов и вибраций 5. TCG Opal 2.0	
Интерфейс	SATA III 6.0 Гб/с			PCIe Gen3x2
Тип флеш-памяти	iSLC (MLC)	MLC	3D TLC	3D TLC
Емкость	16GB~64GB	16GB~128GB	32GB~256GB	32GB~512GB
Макс. канал	4			
Последовательная скорость Чтения/Записи (Мб/сек, макс.)	440/260	410/140	540 / 260	1700/1400
Максимальное энергопотребление	2,3 Вт		1,86 Вт	1,75 Вт
Термо датчик	Нет		Да	Да
DRAM буфер	Нет		Нет	Нет
iData Guard	Нет		Нет	Нет
iCell	Нет		Нет	Нет
TRIM	Да		Да	Да
ATA Security	Да		Да	Да
S.M.A.R.T.	Да		Да	Да
Габариты (ШхДхВ/мм)	16,0 x 20,0 x 1,7			11,5 x 13,0 x 1,4
Рабочая среда	Ударостойкость: 1500G@0,5 мс/Температура в состоянии покоя: -40+85°C/MTBF: >3 миллиона часов			
Стандартный темп. диапазон (0+70°C)	DENSND-XXXD06SC***	DHNSND-XXXD08BC***	DENSND-XXXDK1EC***	DENSND-XXXIG1EC***
Расширенный темп. диапазон (-40+85°C)	DENSND-XXXD06SW***	DHNSND-XXXD08BW***	NA	DENSND-XXXIG1EW***
Примечание	xxx = емкость (02 Гб=02Г, 04 Гб=04Г, 08 Гб=08Г, 16 Гб=16Г, 32 Гб=32Г, 64 Гб=64Г, 128 Гб=A28) ***= конфигурация флеш-памяти (код внутреннего контроля)			

Пограничные утилиты



iSMART
SSD и DRAM
Мониторинг в реальном времени



iOpal
Самошифрующееся
управление дисками



iTracker
SD-карта и USB
управление дисками



iRAID
Мониторинг
RAID модулей



iVINNO
ИИ приложение
для развертывания

Облачная система управления



iCAP

Облачная платформа управления

**Умное
управление**

**Своевременное
прогнозирование**

**Быстрое
обслуживание**

Встраиваемые компоненты

Встраиваемый UDIMM

Модуль UDIMM — это планка памяти, используемая как стандартный компонент для основных встраиваемых систем. Эти модули отвечают стандартам JEDEC и доступны в DDR1, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4 и DDR5.



Серия	Стандартное решение	
Тип модуля	DDR5 UDIMM	DDR4 UDIMM
Скорость передачи данных	4800 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c,
Емкость	8 Гб/16 Гб/32 Гб	2 Гб/4 Гб/8 Гб/16 Гб/32 Гб
Функции	небуферизированная память без ECC	
Число контактов	288-контактная	288-контактная
Ширина	64-разрядная	64-разрядная
Напряжение	1,1 В	1,2 В
Высота печатной платы	1,23 дюйма	1,23 дюйма
Рабочая температура	0+85°C	0+85°C
Защита от сульфирования	√ (бесплатный бонус)	√ (бесплатный бонус)
Дополнительные опции	Конформное покрытие, технология Side Fill, теплоотвод	

Встраиваемые модули SODIMM

Компактные DIMM-модули (SODIMM) — это обычные RAM-модули, используемые как стандартные компоненты для основных встраиваемых систем. Эти модули совместимы со стандартами JEDEC и нет необходимости переделывать систему из-за ограниченного пространства.



Серия	Стандартное решение	
Тип модуля	DDR5 SODIMM	DDR4 SODIMM
Скорость передачи данных	4800 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c
Емкость	8 Гб/16 Гб/32 Гб	2 Гб/4 Гб/8 Гб/16 Гб/32 Гб
Функции	небуферизированная память без ECC	
Число контактов	262 контакта	260-контактная
Ширина	64-разрядная	64-разрядная
Напряжение	1,1 В	1,2 В
Высота печатной платы	1,18 дюйма	1,18 дюймов
Рабочая температура	0+85°C	0+85°C
Защита от сульфирования	√ (бесплатный бонус)	√ (бесплатный бонус)
Дополнительные опции	Конформное покрытие, технология Side Fill, теплоотвод	

Сервер

Регистровая DIMM

Регистровая память DIMM (RDIMM) предназначена для обеспечения целостности данных на уровне устройства и системы сервера. Кроме того, для гарантии стабильной работы все модули Innodisk RDIMM тестируются с использованием нашего эксклюзивного программного обеспечения iRAM.



Серия	Серверные решения	
Тип модуля	DDR5 RDIMM	DDR4 RDIMM
Скорость передачи данных	4800 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c
Емкость	16GB/32GB	4GB/8GB/16GB/32GB
Функции	Регистровая память с ECC	
Число контактов	288-контактная	288-контактная
Ширина	72-разрядная	72-разрядная
Напряжение	1,1 В	1,2 В
Высота печатной платы	1,23 дюйма	1,23 дюйма
Температура эксплуатации	0+85°C	0+85°C
Позолоченные контакты с нанесением в 30 нм	√	√
Защита от сульфирования	√ (бесплатный бонус)	

Расширенный температурный диапазон

Небуферизованные модули DIMM с поддержкой работы в широком температурном диапазоне

Разработанные для промышленных систем, модули Innodisk серии Wide Temperature DRAM являются лучшим выбором для приложений, работающих в суровых условиях окружающей среды. В подобных модулях используются компоненты SDRAM промышленного уровня с позолоченными контактами с покрытием толщиной 30нм, что гарантирует высококачественную передачу сигнала даже при жестких температурах от -40C до +85C.



Серия	Решение с поддержкой расширенного температурного диапазона		
Тип модуля	DDR4 WT UDIMM	DDR4 WT UDIMM VLP	DDR4 WT SODIMM
Скорость передачи данных	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c
Емкость	4GB/8GB/16GB/32GB	8GB/16GB//32GB(sorting WT) 32GB is only for 2666 MT/s	4GB/8GB/16GB/32GB
Функции	Без ECC небуферизированная память		
Число контактов	288-контактная	288-контактная	260-контактная
Ширина	64-разрядная	64-разрядная	64-разрядная
Напряжение	1,2 В	1,2 В	1,2 В
Высота печатной платы	1,23 дюйма	0,738 дюйма	1,18 дюйма
Температура эксплуатации	-40+85°C	-40+85°C	-40+85°C
Позолоченные контакты с нанесением в 30 нм	√	√	√
Защита от сульфирования	√ (бесплатные опции)	√ (бесплатные опции)	√ (бесплатные опции)
Дополнительные опции	Конформное покрытие, технология Side Fill, теплоотвод		

Небуферизованные модули DIMM с ECC и поддержкой расширенного температурного диапазона

Модули серии Wide Temperature ECC DIMM предназначены как для промышленных систем, так и для серверов. Модули DRAM Wide Temperature от Innodisk лучше всего подходят для приложений, которые эксплуатируются при больших перепадах температур. Благодаря функции ECC модули DIMM из данной серии также обеспечивают исправление данных при обнаружении поврежденных битов



Серия	Решение с поддержкой расширенного температурного диапазона	
Тип модуля	DDR4 WT ECC UDIMM	DDR4 WT ECC SODIMM
Скорость передачи данных	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c
Емкость	4GB/8GB/16GB/32GB	4GB/8GB/16GB/32GB
Функции	Небуферизированная память с ECC	
Число контактов	288-контактная	260-контактная
Ширина	72-разрядная	72-разрядная
Напряжение	1,2 В	1,2 В
Высота печатной платы	1,23 дюйма	1,18 дюйма
Температура эксплуатации	-40+85°C	-40+85°C
Позолоченные контакты с нанесением в 30 нм	√	√
Защита от сульфирования	√ (бесплатные опции)	√ (бесплатные опции)
Дополнительные опции	Конформное покрытие, технология Side Fill, теплоотвод	

Серия SODIMM с поддержкой сверх высоких температур

Наши новые модули DDR4 Ultra Temperature предназначены для работы при температурах от -40°C до +125°C, контакты с нанесением позолоты 45 нм и входит бесплатный апгрейд Side Fill.



Серия	Решение с поддержкой расширенного температурного диапазона	
Тип модуля	DDR4 WT SODIMM	DDR4 WT ECC SODIMM
Скорость передачи данных	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c
Емкость	16GB/32GB	16GB/32GB
Функции	Без ECC небуферизированная память	Без ECC небуферизированная память
Число контактов	260-контактная	260-контактная
Ширина	64-разрядная	72-разрядная
Напряжение	1,2 В	1,2 В
Высота печатной платы	1,18 дюйма	1,18 дюйма
Температура эксплуатации	-40+125°C	-40+125°C
Позолоченные контакты с нанесением в 30 нм	√ (в бонус контакты с нанесением позолоты в 45 нм)	
Защита от сульфирования	√ (в бонус Side Fill)	
Дополнительные опции	Конформное покрытие, теплоотвод	

Модули регистровой памяти DIMM с поддержкой расширенного температурного диапазона

Модули серии Wide Temperature DRAM от Innodisk лучше всего подходят для приложений, работающих при больших перепадах температур. В модулях из данной серии используются компоненты SDRAM промышленного класса с позолоченными контактами с покрытием толщиной 30 нм, что гарантирует высококачественную стабильность передачи сигнала даже при температурах от -40°C до +85°C.







Series	Решение с поддержкой расширенного температурного диапазона	
Module Type	DDR4 WT RDIMM	DDR4 WT RDIMM VLP
Data Rate	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c	2133 MT/c, 2400 MT/c, 2666 MT/c, 2933 MT/c, 3200 MT/c
Capacity	4GB/8GB/16GB/32GB	4GB/8GB/16GB 4GB * только с частотой 2133 MT/c и 2400 MT/c
Function	Регистровая память с ECC	
Number of Pins	288-контактная	288-контактная
Width	72-разрядная	72-разрядная
Voltage	1,2 В	1,2 В
PCB Height	1,23 дюйма	0,738 дюйма
Operating Temperature	-40+85°C	-40+85°C
Golden finger 30μ"	✓	✓
Anti-sulfuration	✓ (бесплатные опции)	✓ (бесплатные опции)
Value-added Service (Optional)	Конформное покрытие, технология Side Fill	

CAN bus

CAN bus (Controller Area Network) - это тип последовательной связи, широко используемый в автоматизации, встраиваемых системах и в автоматизированной промышленности. Компания Innodisk разработала периферийный модуль CANbus EMUC-B202 специально для удовлетворения таких потребностей. Имеется двойной порт соединения CAN 2.0B/J1939 с изолированной конструкцией и поддержкой широкого диапазона температур для повышения безопасности системы и её надёжности.

Innodisk EMUC-B202 основан на Linux CDC-ACM и использует кастомизированный SocketCAN, который позволяет разместить два порта. Таким образом, он обеспечивает максимальный комфорт для клиентов при разработке программ. Помимо SocketCAN, Innodisk также предоставляет API (программный интерфейс приложения) для Windows / Linux, тестирования и примеры кодов.

 <p>SocketCAN</p>	 <p>CAN 2.0A/2.0B</p>	 <p>Galvanic Isolation</p>	 <p>SAE J1939</p>
---	---	---	---

Полная поддержка программного обеспечения

Примеры кода API

Используя графический интерфейс или к Command base тестирование, пользователь может легко проверить модули.

Тестовая утилита

Предоставляет примеры кода C / C ++ / C # для ускорения интеграции программного обеспечения.

Поддержка

API можно использовать в Windows, Linux и как дополнение к x86, также доступен кросс-компилятор для ARM системы.



Наименование	EMUC-B202	EGPC-B201
Тип модуля	Модуль преобразования mPCIe – 2 шины CAN 2.0B с изоляцией	Модуль преобразования M.2 – 2 шины CAN 2.0B/J1939 с изоляцией
Основные характеристики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шина CAN 2.0B обратно совместима с 2.0A 2. Поддерживает скорость передачи 100/125/250/500 (по умолчанию)/800/1000K 3. Поддерживает фильтр приема сообщений CAN 4. Сохраняет конфигурацию после аппаратной перезагрузки 5. До 6000 CAN-сообщений в секунду (прием данных) 6. Поддержка режима «только прослушивание» 7. Дополнительный драйвер для Linux SocketCAN 8. Поддерживает высокоуровневый протокол SAE J1939/CANopen (опционально) 9. Нагрузочный резистор активируется/отключается с помощью джампера 10. Имеется дополнительное монтажное отверстие и разъем USB 11. Соответствует стандарту защиты от превышения напряжения 2,5 кВ EN61000-4-5. 12. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2,5 кВ HiPOT защита 13. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (ESD) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. M.2 2260 или 2280 B-M ключи 2. Шина CAN 2.0B обратно совместима с 2.0A 3. Поддерживает скорость передачи 100/125/250/500 (по умолчанию)/800/1000K 4. Поддерживает фильтр приема сообщений CAN 5. Сохраняет конфигурацию после аппаратной перезагрузки 6. До 6000 CAN-сообщений в секунду (прием данных) 7. Поддержка режима «только прослушивание» 8. Дополнительный драйвер для Linux SocketCAN 9. Поддерживает протокол высокого уровня SAE J1939 (опционально) 10. Нагрузочный резистор активируется/отключается с помощью джампера 11. Соответствует стандарту защиты от превышения напряжения EN61000-4-5 2,5 кВ 12. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2,5 кВ HiPOT защита 13. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (ESD) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ
Форм-фактор	mPCIe	M.2 2260/2280
Входной интерфейс	USB 2.0	PCI Express 2.0 x 1
Входной разъем	Mini PCIe или 5-контактный разъем	M.2 B-M x 1
Выходной интерфейс	CANbus 2.0B/ J1939 /CANopen x 2	CANbus 2.0B/ J1939 /CANopen x 2
Выходной разъем	DB-9 x 2	DB-9 x 2
Габариты (ШхДхВ/мм)	30 x 50,9 x 6,1	22 x 60 x 6,1 22 x 80 x 6,1
Рабочая температура	Расширенный температурный диапазон: -40+85°C	Расширенный температурный диапазон: -40+85°C
Информация для заказа	EMUC-B202-W1 (CAN 2.0B) EMUC-B202-W2 (J1939) EMUC-B202-W3 (CANopen)	EGPC-B201-W1 (2260, CAN2.0B) EGPC-B201-W2 (2280, CAN2.0B) EGPC-B201-W3 (2260, J1939) EGPC-B201-W4 (2280, J1939) EGPC-B201-W5 (2260, CANopen) EGPC-B201-W6 (2280, CANopen)



Наименование	EGPC-B4S1	EGPC-B1S1
Тип модуля	Модуль преобразования M.2 - 4 шины CAN 2.0B с изоляцией	Модуль преобразования M.2 – одиночная шина CAN 2.0B с изоляцией
Основные характеристики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совместимость с PCI Express 1.1 2. Соответствует требованиям стандарта ISO 11898-1 3. Шина CAN 2.0B обратно совместима с 2.0A 4. Поддерживает скорость передачи 10/20/50/100/250/500/800/1000K 5. Поддерживает фильтр приема сообщений CAN 6. Поддерживает Linux SocketCAN 7. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2,5 кВ HiPOT защита 8. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (ESD) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 9. Нагрузочный резистор активируется/отключается с помощью джампера 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совместимость с PCI Express 1.1 2. Соответствует требованиям стандарта ISO 11898-1 3. Шина CAN 2.0B обратно совместима с 2.0A 4. Поддержка скорости передачи данных 10/20/50/100/250/500/800/1000K 5. Поддержка фильтра приема сообщений CAN 6. Поддержка Linux SocketCAN 7. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 2,5 кВ HiPOT защита 8. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (ESD) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 9. Нагрузочный резистор активируется/отключается с помощью джампера
Форм-фактор	M.2 2280	M.2 2242
Входной интерфейс	PCI Express 1.1 x 1	PCI Express 1.1 x 1
Входной разъем	M.2 B-M	M.2 B-M
Выходной интерфейс	Шина CAN 2.0B x 4	Шина CAN 2.0B x 1
Выходной разъем	DB-9 x 4	DB-9 x 1
Габариты (ШхДхВ/мм)	22 x 80 x 12,9	22 x 42 x 4,8
Рабочая температура	Расширенный температурный диапазон: -40+85°C	Расширенный температурный диапазон: -40+85°C
Информация для заказа	EGPC-B4S1-W1	EGPC-B1S1-W1

LAN

Сетевые модули GbE LAN от Innodisk в форм-факторе mPCIe и M.2, на чипах Intel Ethernet, обеспечивают высокопроизводительное сетевое соединение 10/100/1000 Мбит/с, поддерживают изоляцию и эксплуатацию в расширенном диапазоне температур, что повышает безопасность и надежность всей системы. Компактный форм-фактор в комплекте с удобной дочерней платой подходит для установки в компьютер с ограниченным пространством, за счет дополнительного крепежного отверстия или планки.

GbE LAN модули без дочерних плат подключаются по кабелю RJ-45, а также через кабели, используемыми заказчиками под задачи конкретных приложений. Сетевые карты Innodisk также легко интегрируются с M12, с водонепроницаемой степенью защиты IP 65/67/68.



Наименование	EMPL-G101	EMPL-G201	EMPL-G102	EMPL-G202
Тип модуля	Модуль в форм-факторе mPCIe - однопортовый GbE LAN с изоляцией	Модуль в форм-факторе mPCIe - 2 порта GbE с изоляцией.	Модуль в форм-факторе mPCIe - 1 горизонтальный порт GbE LAN с изоляцией	Модуль в форм-факторе mPCIe на 2 горизонтальных порта GbE LAN с изоляцией
Основные характеристики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Однопортовый GbE LAN с изоляцией 2. Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. 3. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2 кВ 4. Соответствует стандарту EN61000-4-2 \ (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 5. Удобная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам 6. Имеется крепежное отверстие или планка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Два порта GbE LAN с изоляцией 2. Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. 3. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2кВ 4. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 5. Удобная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам 6. Имеется крепежное отверстие или планка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Один порт GbE LAN с изоляцией 2. Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. 3. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2 кВ 4. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 5. Удобная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам 6. Имеется крепежное отверстие или планка 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Два порта GbE LAN с изоляцией 2. Соответствует стандарту EN61000-4-5 защита от перенапряжения 2 кВ 3. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2 кВ 4. Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ 5. Удобная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам 6. Имеется крепежное отверстие или планка
Форм-фактор	mPCIe	mPCIe	mPCIe	mPCIe
Входной интерфейс	PCI Express 2.1	PCI Express 2.1	PCI Express 2.1	PCI Express 2.1
Входной разъем	mPCIe	mPCIe	mPCIe	mPCIe
Выходной интерфейс	GbE LAN x 1	GbE LAN x 2	GbE LAN x 1	GbE LAN x 2
Выходной разъем	RJ45 x 1	RJ45 x 2	RJ45 x 1	RJ45 x 2
Габариты (ШхДхВ/мм)	30 x 50,9 x 7,6	30 x 50,9 x 7,6	30 x 50,9 x 5,8	30 x 50,9 x 5,8
Рабочая температура	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C
Информация для заказа	EMPL-G101-C1 EMPL-G101-W1 EMPL-G101-C2 (with bracket) EMPL-G101-W2 (with bracket)	EMPL-G201-C1 EMPL-G201-W1 EMPL-G201-C2 (with bracket) EMPL-G201-W2 (with bracket)	EMPL-G102-C1 EMPL-G102-W1 EMPL-G102-C2 (with bracket) EMPL-G102-W2 (with bracket)	EMPL-G202-C1 EMPL-G202-W1 EMPL-G202-C2 (with bracket) EMPL-G202-W2 (with bracket)



Наименование	EGPL-G101	EGPL-G201	EGPL-G102	EGPL-G202
Тип модуля	Модуль в форм-факторе M.2 - 1 порт GbE LAN с изоляцией	Модуль в форм-факторе M.2 - 2 порта GbE LAN с изоляцией	Модуль в форм-факторе M.2 - 1 порт GbE LAN с изоляцией	Модуль в форм-факторе M.2 - 2 порта GbE LAN с изоляцией
Основные характеристики	<ol style="list-style-type: none"> Один порт LAN с изоляцией Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2 кВ Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Удобная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам Имеется крепежное отверстие или планка 	<ol style="list-style-type: none"> Два порта GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2 кВ Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Удобная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам Имеется крепежное отверстие или планка 	<ol style="list-style-type: none"> Один порт GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2кВ Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Удобная и компактная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам Имеется крепежное отверстие или планка 	<ol style="list-style-type: none"> Два порта GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту защиты от перенапряжения 2 кВ EN61000-4-5. Соответствует стандарту IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2:2013 HiPOT защита 2 кВ Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Удобная и компактная дочерняя плата с кабелем для подключения к различным системам Имеется крепежное отверстие или планка
Форм-фактор	M.2 2280	M.2 2280	M.2 2242	M.2 2242
Входной интерфейс	PCI Express 2.1 x 1	PCI Express 2.1 x 1	PCI Express 2.1 x 1	PCI Express 2.1 x 1
Входной разъем	M.2 B-M	M.2 B-M	M.2 B-M	M.2 B-M
Выходной интерфейс	Gbe LAN x 1	GbE LAN x 2	Gbe LAN x 1	GbE LAN x 2
Выходной разъем	RJ45 x 1	RJ45 x 2	RJ45 x 1	RJ45 x 2
Габариты (ШхДхВ/мм)	22 x 80 x 7,1	22 x 80 x 7,1	22 x 42 x 9,15	22 x 42 x 9,15
Рабочая температура	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C
Информация для заказа	EGPL-G101-C1 EGPL-G101-W1 EGPL-G101-C2 (with bracket) EGPL-G101-W2 (with bracket)	EGPL-G201-C1 EGPL-G201-W1 EGPL-G201-C2 (with bracket) EGPL-G201-W2 (with bracket)	EGPL-G102-C1 EGPL-G102-W1	EGPL-G202-C1 EGPL-G202-W1



Наименование	EMPL-G103	EMPL-G203	EGPL-G1N3	EGPL-G2N3
Тип модуля	Модуль в форм-факторе mPCIe - 1 порт GbE LAN	Модуль в форм-факторе mPCIe - 2порта GbE LAN	Модуль в форм-факторе M.2 – 1 порт GbE LAN	Модуль в форм-факторе M.2 – 2порта GbE LAN
Основные характеристики	<ol style="list-style-type: none"> Один порт GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Трансформатор непосредственно на печатной плате для удобной разработки кабеля Внешний светодиодный индикатор скорости 10/100/1000 	<ol style="list-style-type: none"> Два порта GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Трансформатор на печатной плате для удобной разработки кабеля Внешний светодиодный индикатор скорости 10/100/1000 	<ol style="list-style-type: none"> Один порт GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Трансформатор на печатной плате для удобной разработки кабеля Внешний светодиодный индикатор скорости 10/100/1000 	<ol style="list-style-type: none"> Два порта GbE LAN с изоляцией Соответствует стандарту EN61000-4-2 (электростатический разряд) Воздух-15кВ, Контакт-8кВ Трансформатор на печатной плате для удобной разработки кабеля Внешний светодиодный индикатор скорости 10/100/1000
Форм-фактор	mPCIe	mPCIe	M.2 2280	M.2 2280
Входной интерфейс	PCI Express 2.1	PCI Express 2.1	PCI Express 2.1 x 1	PCI Express 2.1 x 1
Входной разъем	mPCIe	mPCIe	M.2 B-M	M.2 B-M
Выходной интерфейс	GbE LAN x 1	GbE LAN x 2	GbE LAN x 1	GbE LAN x 2
Выходной разъем	RJ45 x 1	RJ45 x 2	RJ45 x 1	RJ45 x 2
Габариты (ШхДхВ/мм)	30 x 50,9 x 7,6	30 x 50,9 x 7,6	22 x 80 x 9	30 x 50,9 x 7,6
Рабочая температура	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C	Стандартная темп.: 0+70°C Расширенный темп. диапазон: -40+85°C
Информация для заказа	EMPL-G103-C1 EMPL-G103-W1	EMPL-G203-C1 EMPL-G203-W1	EGPL-G1N3-C1 EGPL-G1N3-W1	EGPL-G2N3-C1 EGPL-G2N3-W1

Для приложений видеонаблюдения

Современные системы видеонаблюдения прошли долгий путь модернизации. Цифровизация и технологии, такие как «Power over Ethernet»(PoE), означают постоянное повышение требований к увеличению пропускной способности, сохранению, а также извлечению данных видеонаблюдения. Однако основной проблемой по-прежнему остается стабильность записи данных.

Компания Innodisk предлагает решения с большой емкостью и высокой пропускной способностью. InnoREC представляет собой запатентованную разработку компании Innodisk, предназначенную специально для применения в системах видеонаблюдения на базе флэш-памяти. Высокая скорость записи данных и устойчивая производительность накопителей, требующиеся для современных решений систем видеонаблюдения, обеспечиваются за счет гибкой интеграции программной и аппаратной части.



RECLine™



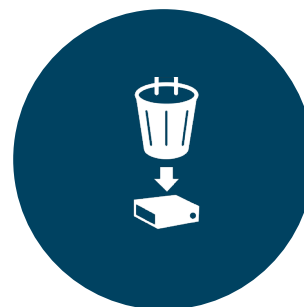
Очистка памяти

Эффективное распределение блоков, их использование и удаление



Выравнивание износа

Технология оптимизированного выравнивания износа (wear leveling), функционирующая совместно с технологией очистки памяти



Функция «TRIM»

Обеспечивает более быстрое удаление неиспользуемых данных, чтобы освободить больше места для записи данных

InnoREC™

RECLine™

RECLine™ - это эксклюзивный алгоритм программы для видеозаписи, который обеспечивает стабильную запись без потери кадров.



Passive Cooling

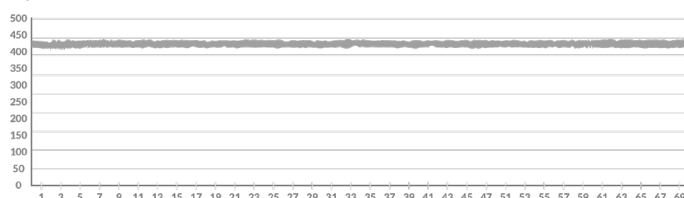
Конструкция SSD разработана для достижения максимальной теплоотдачи – этим обеспечивается высокая производительность и надежность хранения данных.

iCell

С помощью нашей технологии iCell все данные, временно хранящиеся в энергозависимых DRAM модулях, будут мгновенно перенесены во Flash-память, чтобы обеспечить безопасность данных во время сбоев питания.

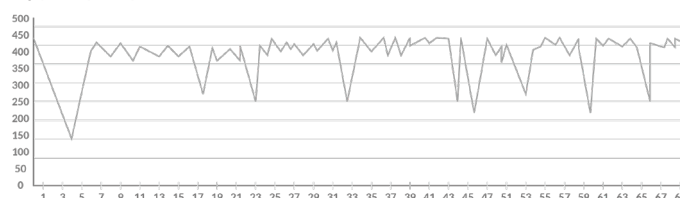


w/RECLine™



Стабильная характеристика при длительной записи для 430 Мб/с (для 2.5" SATA SSD 3MV2-P 1ТБ)

w/o RECLine™



Нестабильность характеристики при длительной записи

Твердотельные накопители



Модель	2.5" SATA SSD 3MV2-P	SATA Slim 3MV2-P	Cfast 3MV2-P	M.2 (S80) 3MV2-P	mSATA 3MV2-P
Интерфейс	SATA III 6.0 Гбит/с				
Тип памяти	MLC	MLC	MLC	MLC	MLC
Емкость	8 Гбайт-2 Тбайт	8 Гбайт-256 Гбайт	32 Гбайт-256 Гбайт	32 Гбайт-1 Тбайт	8 Гбайт-512 Гбайт
Каналы (макс.)	4	4	4	4	4
Скорость чтения/записи (Мбайт/с, макс.)	520/480	520/460	560/450	560/450	520/290
Энергопотребление (макс.)	6 Вт (5В x 1.2 мА)	2.6 Вт (5В x 520 мА)	2.5 Вт (3.3В x 760 мА)	3.63 Вт (3.3 В x 1.1 мА)	2.2 Вт (3.3 В x 0.66 мА)
Датчик температуры	Да				
Буфер ОЗУ	Да				
Функция iCell	Опционально	Нет			
Функция TRIM	Да				
Функция защиты	Да				
Функция S.M.A.R.T	Да				
Размеры (мм)	69.8 x 100.0 x 6.9 (8GB-1TB) 69.8 x 100.0 x 9.5 (2TB)	54.0 x 39.0 x 4.0	42.8 x 36.4 x 3.6	22.0 x 80.0 x 3.5	29.85 x 50.8 x 3.6
Условия работы/хранения	Vibration: 20G@7~2000Hz Shock: 1500G@0.5ms Storage Temperature: -55°C ~ +95°C MTBF: >3 million				
Стандартный(0°C~+70°C)	DVS25-XXXD81%С*** (P)	DVSLM-XXXD81%С***	DVCFA-XXXD81%С***	DVM28-XXXD81%С***	DGMSR-XXXD81%С***
Промышленный(-40°C~+85°C)	DVS25-XXXD81%W*** (P)	DVSLM-XXXD81%W***	DVCFA-XXXD81%W***	DVM28-XXXD81%W***	DGMSR-XXXD81%W***
Пояснение	xxx = емкость (02 Гбайт=02G, 04 Гбайт=04G, 08 Гбайт=08G, 16 Гбайт=16G, 32 Гбайт=32G, 64 Гбайт=64G, 128 Гбайт=A28, 256 Гбайт=B56, 512 Гбайт=C12, 1 Тбайт=01T, 2Тбайт=02T)***= конфигурация флэш-памяти (внутренний контрольный код) %=тип флэш-памяти				

Модули ОЗУ

Небуферизованный LONG DIMM / SODIMM

Небуферизованные модули LONG DIMM и SODIMM DRAM оптимально подходят для видеонаблюдения. Низкопрофильный DIMM (VLP) также улучшает поток воздуха внутри системы и уменьшает тепловой удар.



Серия	Стандартное решение		Очень низко-профильное (VLP) решение	
Тип модуля	DDR4 LONG DIMM	DDR4 SODIMM	DDR3 LONG DIMM	DDR4 SODIMM
Частота	2133 / 2400 / 2666 МГц			
Емкость	4/ 8/ 16 Гбайт	2/ 4/ 8/ 16 Гбайт	4/ 8/ 16 Гбайт	4/ 8 Гбайт
Функции	Без буфера, без ECC			
Число контактов	288 пин	260 пин	288 пин	260 пин
Ширина	64 бит			
Питание	1,2 В	1,2 В	1.2 В	1.2 В
Высота печатной платы	1.23 дюйма	1,18 дюйма	0.738 дюйма	0.7 дюйма
Рабочая температура	0 ~ 85°C			
Дополнительная услуга	Конформное покрытие / Side Fill			

Периферийные модули (EP)



Модель	EGPL-G2P1	EMPL-G2P1	EMPS-32R1
Тип модели	M.2 to dual Isolated PoE Module	mPCIe to dual Isolated PoE Module	mPCIe to dual SATA III RAID module
Форм-фактор	M.2 2280	mPCIe	mPCIe
Интерфейс ввода	PCI Express 2.1 x 1	PCI Express 2.1	PCI Express 2.0
Разъем ввода	M.2 B-M	mPCIe	mPCIe
Интерфейс вывода	PoE x 2	PoE x 2	SATA III
Разъем вывода	RJ45 x 2	RJ45 x 2	SATA 7 Pin x 2
Размеры (мм)	22 x 80 x 7.1	30 x 50.9 x 7.6	30 x 50.9 x 10.7
Температурный диапазон	Стандартный: 0°+70°C Промышленный: -40°+85°C	Стандартный: 0°+70°C Промышленный: -40°+85°C	Стандартный: 0°+70°C Промышленный: -40°+85°C
Информация для заказа	EGPL-G2P1-C1 (Mounting hole, 4pin header) EGPL-G2P1-W1 (Mounting hole, 4pin header) EGPL-G2P1-C2 (Bracket, 4pin header) EGPL-G2P1-W2 (Bracket, 4pin header) EGPL-G2P1-C3 (Mounting hole) EGPL-G2P1-W3 (Mounting hole, DC Jack) EGPL-G2P1-C4 (Bracket, DC Jack) EGPL-G2P1-W4 (Bracket, DC Jack)	EMPL-G2P1-C1 (Mounting hole, 4pin header) EMPL-G2P1-W1 (Mounting hole, 4pin header) EMPL-G2P1-C2 (Bracket, 4pin header) EMPL-G2P1-W2 (Bracket, 4pin header) EMPL-G2P1-C3 (Mounting hole, DC Jack) EMPL-G2P1-W3 (Mounting hole, DC Jack) EMPL-G2P1-C4 (Bracket, DC Jack) EMPL-G2P1-W4 (Bracket, DC Jack)	EMPS-32R1-C1 EMPS-32R1-W1

Absolute Integration™

Absolute Integration™ - это намеченная нами концепция развития, ведущая на новые уровни взаимодействия.

«Для нас интеграция - это не просто сочетание аппаратного, программного и микропрограммного обеспечения, это целая философия, которая объединяет все соответствующие элементы с целью создания оптимального решения».

Для более подробной информации о гарантии на изделия, пожалуйста, обращайтесь в продаж

Innodisk или посетите наш веб-сайт:

www.innodisk.com

Головной офис

Тайвань

5F., No.237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi
Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

T +886-2-7703-3000
Ф +886-2-7703-3555
E sales@innodisk.com

Филиалы:

Япония

2F., 1-1-14, Nihonbashi-
Ningyocho, Chuo-ku, Tokyo,
103-0013 Japan
T +81-3-6667-0161
Ф +81-3-6667-0161
E jpsales@innodisk.com

Голландия

Insulindelaan 115A,
5642CV, Eindhoven,
Netherlands
T +31-40-3045-400
Ф +31-40-3045-419
E eusales@innodisk.com

Франция

Immeuble Arago 141 boulevard Vauban
78280 Guyancourt.
T +33 (0)6 25 35 28 99

США

42996 Osgood Road,
Fremont, CA 94539 USA
T +1-510-770-9421
Ф +1-510-770-9424
E usasales@innodisk.com

9 Timber Ln, Marlboro NJ 07746
T +1-732-8530455
Ф +1-732-7846401

Китай

807, 8 Floor, Building B,
Hengyue Center, Dengliang
Road, Nanshan District,
Shenzhen
T +86-755-2167-3689
+86-755-2167-3690
Ф +86-755-2167-3691
E sales_cn@innodisk.com

Шанхай **T** +86-021-64198038
T +86-021-64195356
Пекин **T** +86-010-82458120
T +86-010-82458130
Чэнду **T** +86-028-67197490
Ухань **T** +86-027-81941314

